MERS

dấu hiệu $R_{AD.} = R_{Chùm} + R_{0} = 794$, độ lệch và nắp cáp-Itanox C 0 = 54 NF và C 1 = 70 pf đã được đo lường sử dụng bộ phân tích trở kháng ở mức 1 .26 MHz. Thiết bị đầu cuối Một sư mất tập trung 1 m tâm T3 và T4 được nối đất. Điện áp Bu er er fi er được sử dụng để giảm thiểu các tác phẩm của cáp và máy phân tích phố trên opera động cơtion. Trong hình 3b dc gia nhiệt điện trở có thể dẫn đến một nhiệt độ tăng cường của chùm tia chống lại sự làm mớicơ chế xây dưng. Nó được ước tính từ nhiệt đôsư phu thuộc của sức đề kháng và từ FEM sim-Nhiễm trùng rằng nhiệt độ tối đa của động cơ chùm là 370 ± 20 K và Tôlan = 3 mA (xem bổ sung C). Nhiệt đô này tăng 17% bằng DC hệ thống sưởi ấm tương đối nhỏ so với yếu tố

5 đã ra lệnh trong T k Kết quả của việc giảm Q Chúng tôi cảm ơn J.J.M. Ruigrok, C.S Vaucher, K. Reimann, R. Woltier và E.P.A.M. Bakkers cho các cuộc thảo luận và Sug-Gestions và cảm ơn J. V. Wingerden vì sư hỗ trợ của anh ấy với các phép đo SEM. Các tác giả tuyên bố rằng Ho không có lợi ích tài chính canh tranh. Tác giả con-Tuần đình: K.L.P., P.G.S., J.T.M.V.B. và M.J.G. TRONGthông hơi và thiết kế thiết bị. P.G.S., K.L.P., M.J.G. và C.V.D.A. thực hiện các thí nghiệm. P.G.S. sư phát triểnops the lý thuyết, phân tích các thí nghiệm và viết bài báo. J.T.M.V.B., G.E.J.K. và G.J.A.M.V. không đúng veloped công nghệ quy trình và sản xuất Phó. Được gửi đến P.G.S. (Peter.steeneken@nxp.com).

Epstein, A. H. MILIMARTER-Kích thước, cơ điện tử cơ điện
 Hệ thống động cơ tuabin khí.
 J. Eng. Tua bin khí năng lượng
 126, 205 bóng226 (2004).
 Jacobean S. A. & Epstein A. H. Một quốc khảo cát không chích thức vẫ

² Jacobson, S. A. & Epstein, A. H. Một cuộc khảo sát không chính thức về quyền lực MEMS . Int. Symp. Micro-mech. Eng. (Ismme) PK18 (2003)

3 Spadaccini, C. M. & Waitz, I. A. Toàn diện microsys-Tem , chap. 3.15 C-Callingtion (Elsevier, Amsterdam, 2008)

4 Peterson, R. B. Giới hạn kích thước cho động cơ nhiệt tái tạo. Kỹ thuật vật lý nhiệt nano và kính hiển vi 121 bóng131 (1998).

5 Wil fi nger, R. J., Bardell, P. H. & Chhabra, D. S.
Resonistor: một thiết bị chọn lọc tần số sử dụng mecộng hưởng chanical của chất nền silicon.

12, 113 bóng117 (1968).

IBM J. Res. Dev.

6 Elwenspoek, M. et al. Cơ chế tải nạp và Ứng dụng của họ trong các thiết bị vi mô. MEMS 126 Từ132 (1989).

Proc. IEEE

2 .

Các

7 Lammerink, T., Elwenspoek, M. & Fluitman, J. Tần số Sự phụ thuộc của sự kích thích nhiệt của cơ học vi mô onators. Sens. Hành động. MộT 25 trận27, 685 bóng689 (1991).

8 Nhìn, H. et al. Nhiệt kim loại từ tính fl exure bộ truyền động. Hội thảo cảm biến trạng thái rắn IEEE và bộ truyền động 5,73 trận75 (1992).

9 Rèichenbach, R. B., Zalalutdinov, M., Parpia, J. M. & Craighead, H. G. Rf mems Dao động với tích hợp Điện trở. IEEE ELEL Dev. L. 27, 805 bóng807 (2006).

SEO, J. H. & Brand, O. High Q. -factor in-plane-mode-Nên tảng Microsensor cho môi trường khí/lỏng. J. Mems 17 , 483 bóng493 (2008).

11 Cohadon, P., Heidmann, A. & Pinard, M. Làm mát a Gương bằng áp suất bức xạ. Vật lý. Rạn san hô. Lett. 83 , 3174... 3177 (1999).

¹² Metzger, C. H. & Karrai, K. Làm mát khoang của một microlever.

Thiên nhiên 432 , 1002 bóng1005 (2004).

13 Arcizet, O., Cohadon, P.-F., Briant, T., Pinard, M. & Hei-Dmann, A. Làm mát áp suất bức xạ và cơ học

Sự không ổn định của micromirror. Thiên nhiên 444 ,71 bóng74 (2006). ¹⁴ Kleckner, D. & Bouwmeester, D. Làm mát quang học Sub-Kelvin

của một bộ cộng hưởng vi mô. Thiên nhiên 444 ,75 bóng78 (2006).

15 Schliesser, A., Del hèHaye, P., Nooshi, N., Vahala, K. J. & Kippenberg, T. J. Làm mát áp suất bức xa của micromeBộ tạo dao động Chanical sử dụng mặt sau động. Vật lý. Rev.

Lett. 97 , 243905 (2006).

16 Brown, K. R. et al. Làm mát thụ động của một cơ học vi mô dao động với mạch điện cộng hưởng. Vật lý. Rạn san hô. Lett. 99 , 137205 (2007).

17 Metzger, C., Favero, I., Ortlieb, A. & Karrai, K.

cal tự làm mát của một biến dạng F ám đạm P khoang erot trong Giới hạn cổ điển. Vật lý. Mục sư b 78, 035309 (2008). 18 Teufel, J., Donner, T., Castellanos-Beltran, M. A., Harlow,

J. & Lehnert, chuyển động cơ học nano được đo bằng một sự thiếu chính xác dưới đây ở giới hạn lượng tử tiêu chuẩn.
công nghệ nano thiên nhiên. 4,820 bóng823 (2009).

19 Feynman, R. P., Leighton, R. B. & Sands, M. Feynngười đàn ông giảng bài về vật lý , tập. Tôi, Ch. 46 (Addison-Wesley, Đọc, 1963).

2º Spadaccini, C. et al. Đốt cháy silicon mật độ cao
 Hệ thống cho động cơ tuabin khí vi mô. Proc. Asme/Igti
 Triển lãm Turbo GTTHER2002 Từ30082 (2002).
 K"oser, H. & Lang, J. Mô hình mật độ công suất cao

Máy cảm ứng từ tính.
Proc. Công nghệ nano MSM (2001).
Proc. Công nghệ nano MSM (2001).
Rộ truyền động quay dựa trên

ống nano carbon. tự nhiên 424 , 408 bóng410 (2003).
²³ Fan, D. L., Zhu, F. Q., Cammarata, R. C. & Dog, C. L.

Vòng quay tốc độ cao có thể điều khiển của dây nano.

Vòng quay tốc độ cao có thể điều khiển của dây nano. Vật lý. Rev. Lett. 94 , 247208 (2005).

Ayari, A. et al. Tự dao động trong các dây nano phát thải
 Bộ cộng hưởng cơ học: Một chuyển đổi DC-AC nanometric.
 Nano Lett. 7, 2252 Từ2257 (2007).
 Weldon, J. A., Alem'an, B., Sussman, A., Gannett, W.

& Zettl, A. K. Tự dao động cơ học bền vững trong Ông nano carbon. Nano Lett. 10 , 1728 Từ1733 (2010). Ebefors, T. & Voice, G. Sổ tạy MEMS: MEMS

Úng dụng , chap. Microrobotics (CRC Press, Boca RAtấn, 2006).

Burg, T. P. et al. Cân của các phân tử sinh học, các tế bào đơn và các hạt nano đơn trong uid. tự nhiên 446 , 1066 (2007).
 Bullis, W. M., Brewer, F. H., Kolstad, C. D. & Swartzen-

Druber, L. J. Nhiệt độ hệ thống điện trở suất của SIL-Biểu tượng và Germanium gần nhiệt độ phòng. Trạng thái rắn Điện tử 11 , 639 Từ646 (1968).